論文の内容の要旨

光電子分光による低次元有機導体の電子状態の研究

小泉健二

第1章 序論

固体で発現する諸物性はその電子状態と深く結びついており、特に物質のフェルミ準位 (*E*_r)近傍の電子状態を知ることは物質の設計や応用にとって非常に重要である。その電子状 態を直接観測することのできる手法として角度分解光電子分光(ARPES)がある。この手法 は占有状態を直接観測できるのみではなく、電子構造を運動量まで分解して観測すること のできるほぼ唯一の方法であり、非常に強力である。

有機導体はその低次元性に基づく電荷密度波(CDW)やスピン密度波(SDW)、エキゾチック超伝導など多彩な基底状態を取りうるとともに、金属相においても次元のクロスオーバーによる Fermi 液体から Tomonaga-Luttinger 液体へのクロスオーバーなど、多様な物性を含む独特で魅力的な物質群である。しかし有機導体は試料の取り扱いが難しく、測定が困難なことから、特に ARPES の報告は世界的にもほとんどない。

VUV レーザー(7eV)を用いた ARPES[1]は、レーザーの単色性により高分解能であるだけ でなく、低エネルギーのため光照射による損傷を抑えることができ、また有機導体中で伝 導を担う s,p 電子に対するクロスセクションが大きいといった特徴を持つ。さらにはバルク 敏感性も併せ持つため、有機導体の測定に有利な手法である。そこで、我々は VUV レーザ ー光電子分光を用いて、典型的な CDW 物質である TSF-TCNQ の及び典型的な SDW 物質 であり次元クロスオーバーを示す(TMTSF)2PF6の電子状態とその温度変化を詳細に調べた。

第2章 低次元有機導体の基礎物性

一次元導体では電子-格子相互作用により、パイエルス転移を示し、電荷密度波(CDW) を生じることが知られている[2]。一般的に CDW 転移はフェルミ面をネスティングベクト ル(QcDw)だけ平行移動した時の重なりであるフェルミ面のネスティングの良さに支配され ている。一次元系では平行な 2 枚のフェルミ面が実現しており、QcDw = 2kr に対して良い フェルミ面のネスティングを示すため、低温で 2kr-CDW を生じる。一方、次元性によって 金属相での振舞が異なることが知られている。二次元や三次元では Fermi 液体に従う振舞 を示し、低エネルギーの電子状態は準粒子励起として振舞う。これに対して、一次元では 相互作用の効果が非常に強く現れるために、電子-電子相互作用がたとえ弱くても準粒子 励起が抑制され、低エネルギーの電子状態は電荷とスピンの集団励起になり、

Tomonaga-Luttinger 液体に従う振舞を示す。このため、現実の系で実現される擬一次元導体では一次元伝導鎖間のホッピングにより一次元から二次元へのクロスオーバーが起こり、 金属相で Tomonaga-Luttinger 液体から Fermi 液体へのクロスオーバーが示唆されている [3]。

このように擬一次元導体では電子一格子相互作用や電子一電子相互作用が競合的に顕著 に現れるため、二次元や三次元導体とは異なった独特で多彩な物性を示す。そのためその 電子状態を理解することは非常に重要である。しかし、今まで一次元系での電子状態の研 究は無機物を中心に行われてきたが、二次元系の中に現れる一次元性を議論しているもの が多く、擬一次元導体の研究は少ない。その中で、たとえば典型的な擬一次元 CDW 物質の K_{0.3}MoO₃や BaVS₃があるが、前者は CDW 転移点が 180K と高く、また後者は多軌道であ り複雑な振舞を示すため、それらの研究[4,5]からは、擬一次元導体の電子状態、特に金属 相の電子状態に関する知見は得られておらず、擬一次元導体で発現する物性の全容は未だ に明らかではない。そこで我々は有機導体に注目した。

第3章 光電子分光

光電子分光は固体の電子状態を直接観測できる非常に強力な実験手法であるが、有機導体では劣化の問題により測定が困難であった。しかし今回 7eVのVUV レーザーを用いることでその問題を克服した。これはガスを使わないため吸着劣化が少なく、低エネルギーのため光照射によるダメージが低く抑えられるためである。さらにこのレーザーは有機導体の電気伝導を担う sやp電子に対して高いクロスセクションを有し、さらには光電子が低運動エネルギーであるためバルク敏感性も併せ持ち、効率のよい高精度測定が可能となった。

第4章 TSF-TCNQの角度分解光電子分光

TSF-TCNQは典型的な擬一次元導体であり、低温で2kF-CDWを形成する。さらに電子構造が単純で、CDW転移点は29Kと低く、擬一次元導体の電子状態を明らかにするのに

最適な物質であるといえる。この TSF-TCNQ は X 線散乱実験から室温から温度を下げてい くと 200K 程度で一次元の 2*k*_F-CDW ゆらぎが生じ、100K でゆらぎが 2 次元的になり、55K で三次元の短距離秩序を形成し、最終的に 29K で三次元の長距離秩序を形成することが知 られている[6]。

図1は第1ブリルアンゾーンの Erの強度プロットの温度依存性であり、強度はすべて規

格化してある。これからすべて一次元的な形状であるこ とがわかる。しかし、その強度と鋭さに違いが見られる。 250K から 60K では強度が増大しつつ鋭くなっている。 これは 60K において運動量が良い量子数になっている ことを示している。また、60K から 6K では鋭さはその ままに強度が減少している。これは 6K で CDW ギャッ プが開くためである。



このARPES 結果において *E*r近傍に準粒子ピークが現 れる T*=200K は、ちょうど X 線散乱[6]で一次元的な 2*k*_F-CDW ゆらぎが観測され始める温度 T_{1D} に対応して

いる。このことは T*以下で系のコヒーレンスが良好になりフェルミ面が明瞭になるととも に、ネスティングが効くようになることを示唆しており、CDW 転移には準粒子が形成され、 運動量が良い量子数になることが必要であることがわかった。

また低温においては 0.2eV という大きなスケールの折れ曲がり(キンク)構造を観測した。 これは電子分子内振動相互作用や電子電子相互作用の繰込みが起きていることが考えられ る。

第5章 (TMTSF)₂PF₆の角度分解光電子分光

(TMTSF)₂PF₆は多彩な物性を有するが、今まで ARPESの測定が困難であり、成功報告はなかった。 そこでレーザーARPESを用いて測定を行った。その 結果、図 3.(a)に示したように(TMTSF)₂PF₆のバンド 分散を世界で初めて観測し、t_a=380meV としたとき の Tight-binding 計算の結果[7]とよく合う分散が得 られた。従って(TMTSF)₂PF₆は弱相関であることが わかった。また(TMTSF)₂PF₆のフェルミエッジも観 測された(図 3(b))。これは(TMTSF)₂PF₆の 2 次元性 を反映していると考えられる。さらには



 $(TMTSF)_2PF_6$ のフェルミ面も初めて観測することに成功(図 3(c))し、1 次元的だがワーピン グしているフェルミ面が得られた。 $t_a=380$ meV, $t_b=10$ meV とした場合の Tight-binding 計算 の結果とよく合うことから、得られたフェルミ面は計算結果の t_b の値よりも小さく計算結 果は2次元性を過大評価していることがわかった。

第6章 次元性と電子状態

2次元や3次元金属では素励起が準粒子であり、フェルミ準位近傍の状態密度に有限のと びが観測される。一方、1次元金属では相互作用がたとえ弱くても準粒子が抑制され、フェ ルミ準位近傍にはなだらかな立ち上がりになりとびは観測されない。そこで(TMTSF)₂PF6 とTSF-TCNQ、TTF-TCNQの次元性の違いとフェルミ準位近傍の状態密度を比較してみ た。その結果1次元性が弱い(TMTSF)₂PF6ではフェルミエッジが観測され、1次元性の強 いTSF-TCNQとTTF-TCNQではフェルミエッジが観測されなかった。したがってフェル ミ面の2次元性とフェルミ端が対応していることがわかった。

第7章 まとめ

TSF-TCNQ

CDW 転移には準粒子が形成され、運動量がよい量子数になることが必要 大きなエネルギースケールのキンク構造が観測され電子分子内振動相互作用や電子電子相 互作用の繰込みが起きていることが考えられる。

(TMTSF)₂PF₆

初めて電子構造を直接観測し、20Kでは2次元か3次元金属であり、フェルミ液体に従う ことが示された。

次元性と電子状態

擬1次元有機導体(TMTSF)₂PF₆とTSF-TCNQ、TTF-TCNQのフェルミ面と状態密度を比較した結果フェルミ面の2次元性とフェルミ端が対応していることがわかった。

参考文献

- [1]T. Kiss et al., Phys. Rev. Lett. 94, 057001 (2005); T. Kiss et al., Rev. Sci. Instrum. 79, 023106 (2008).
- [2]G. Grüner, Density Waves in Solids (Addison-Wesley, Massachusetts, 1994)
- [3]S. Biermann et al., Phys. Rev. Lett. 27, 276405 (2001).
- [4]L. Perfetti et al., Phys. Rev. B 66, 075107 (2002).
- [5]S. Mitrovic et al., Phys. Rev. B 75, 153103 (2007).
- [6]S. Kagoshima et al., Solid State Commun. 28, 485 (1978).
- [7]P. M. Grant, J. Physique 44(1983)C3-847.